Corrigé Type: (EXAMEN DE PHYSIQUE DES SEMI-CONDUCTEURS) 2022/2023

Exercice 1 6 pls



1.
$$n = N_c e^{-\frac{(E_c - E_F)}{kT}}$$
 , $p = N_v e^{\frac{(E_v - E_F)}{kT}}$

Pour un SC intrinsèque n = p = n

$$n.p = n_i^2 = N_c N_v e^{-\frac{(E_c - E_v)}{kT}} \Rightarrow n_i = (N_c N_v)^{1/2} e^{-\frac{E_g}{2kT}} / A = \sqrt{N_c N_v}$$

- Les façons d'amener un électron de la bande de valence à la bande de conduction :
 - En augmentant la température,



- Avec la lumière,
- Avec un gros champ
- 3. L'expression générale de la densité de courant total circulant dans un semi-conducteur :



$$\vec{J} = \vec{J}_n + \vec{J}_p = n \ e \mu_n \vec{E} + e D_n \overline{grad} n + p \ e \mu_p \vec{E} - e D_p \overline{grad} p$$



$$4. \quad \sigma = n_i e(\mu_n + \mu_p)$$

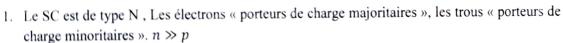
 $R = \rho \cdot \frac{L}{S}$, $\rho = \frac{1}{\sigma} = \frac{1}{1.6.10^{-19}.10^{10}.(1350+480)} = 3,41.10^5 \,\Omega.cm$



Région (1): Région des hautes températures, le régime est intrinsèque. $\mathbf{n} = (N_c N_v)^{1/2} e^{-\frac{E_g}{2kT}}$ Région (2) : Région des basses températures, régime d'épuisement des donneurs. $n = N_d$ Région (3) : Région des très basses températures, $n = \left(\frac{1}{2}N_d N_c\right)^{1/2} e^{-\frac{(E_c - E_d)}{2kT}}$ régime de gel

Exercice 2 7 pts

des électrons.





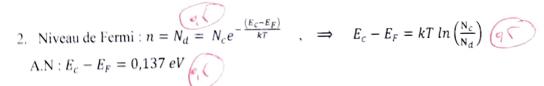
A T ambiante $N_d = N_d^+$, la concentration des électrons est :

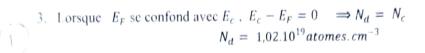
$$n = N_d = 5.10^{16}$$
 électrons libres. cm⁻³

La concentration des trous : $n.p = n_i^2 \implies p = \frac{n_i^2}{n}$

$$n_i = (N_c N_v)^{1/2} e^{-\frac{E_g}{2kT}} = 2,13.10^{13} \text{ porteurs/cm}^3$$

$$p = \frac{n_i^2}{n} = 9,07.10^9 \text{ trous libres/cm}^3$$





4. Si le nombre d'électrons de conduction provenant de la bande de valence est égal au nombre d'électrons provenant du niveau d'énergie E_d , soit $n_l = N_d$

$$n_{i} = (N_{c}N_{v})^{1/2}e^{-\frac{E_{g}}{2kT}} = N_{d}$$

$$\Rightarrow T = \frac{E_{g}}{2kln(\frac{\sqrt{N_{c}N_{v}}}{N_{d}})} \approx 765.2 \text{ K}$$

Exercice 3 7pts

$$n_{n} = N_{c}e^{-\left(\frac{E_{cn}-E_{F}}{kT}\right)}, n_{p} = N_{c}e^{-\left(\frac{E_{cp}-E_{F}}{kT}\right)} \Rightarrow E_{cp} - E_{cn} = kT \ln \frac{n_{n}}{n_{p}} = kT \ln \frac{N_{d}N_{a}}{n_{l}^{2}}$$

$$E_{cp} = -eV_{p} , E_{cn} = -eV_{n} \Rightarrow V_{d} = \frac{E_{cp}-E_{cn}}{e}$$

$$\Rightarrow V_{d} = \frac{kT}{e} \ln \frac{N_{d}N_{a}}{n_{l}^{2}}$$

2. le champ électrique E(x) à l'intérieure de la zone de charge d'espace

$$\frac{dE(x)}{dx} = \frac{\rho(x)}{\varepsilon} \implies \begin{cases} \frac{dE(x)}{dx} = \frac{-eN_a}{\varepsilon} & -x_p < x < 0 \\ \frac{dE(x)}{dx} = \frac{eN_d}{\varepsilon} & 0 < x < x_n \end{cases}$$

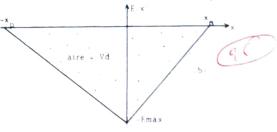
$$\Rightarrow \begin{cases} E(x) = -\frac{eN_a}{\varepsilon} (x + x_p) & -x_p < x < 0 \\ E(x) = \frac{eN_d}{\varepsilon} (x - x_n) & 0 < x < x_n \end{cases}$$

3. La relation entre N_a , N_d , x_p et x_n

 $\hat{A} x = 0$, le champ est continu, donc on a :

$$-\frac{eN_a}{\varepsilon}x_p = -\frac{eN_d}{\varepsilon}x_n = -E_{Max} \implies N_a x_p = N_d x_n$$

Représentation du champ électrique E(x)



4. Détermination du potentiel électrique V(x) dans chaque région de la jonction.

Le potentiel électrostatique est lié à la répartition de charge par : $\frac{d^2v}{dx^2} = -\frac{\rho}{\varepsilon}$

L'intégration du champ électrique nous donne le potentiel électrique

$$V(x) = -\int E(x) dx$$

$$x = -x_p, \quad V = V_p \quad / \quad x = x_n, \quad V = V_n$$

$$\begin{cases} V(x) = \frac{eN_a}{2\varepsilon} (x + x_p)^2 + V_p & -x_p < x < 0 \\ V(x) = V_n - \frac{eN_d}{2\varepsilon} (x - x_n)^2 & 0 < x < x_n \end{cases}$$